



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20090424000C
2010年9月22日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

TI-MIH08 サイト製造 HPA一部製品 前処理工程 ウェーハサイズ追加変更のご案内

(認定済 171 製品への追加認定 14 製品の連絡)

(第三版 PCN20090424000B 2010年3月12日発行)

(第二版 PCN20090424000A 2010年1月14日発行, 初版 PCN20090424000 2009年4月30日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30**日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後**30**日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より**90**日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	下記変更について認定済171製品への追加認定14製品の連絡になります。 TI-MIH08サイト製造 HPA一部製品 前処理工程 ウェーハサイズ追加変更 現行 : TI-MIH08(日本) 150mmウェーハ前処理 変更後 : TI-MIH08(日本) 150mm/200mmウェーハ前処理			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	追加認定品は 2011 年 1 月上旬の出荷より予定しています。 認定終了品は 2009 年 8 月上旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済171製品への追加認定14製品(33A12プロセス)の連絡になります。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI-MIH08(日本)サイト製造 一部製品について、現行 50A12/33A12 プロセス 150mmウェーハ前処理にて製造いたしておりますが、これに加え200mmウェーハ前処理での製造を追加し認定いたしました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
ウェーハサイズ	150mmウェーハ	150mmウェーハ 200mmウェーハ

	現行	追加変更
TI-MIH08 50A12 プロセス	150mm ウェーハ	200mm ウェーハ
TI-MIH08 33A12 プロセス	150mm ウェーハ	200mm ウェーハ

理由：製品安定供給確保の為

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名

■:追加認定品 □:認定終了品

HPA00054ZQVR	TLC4545IDGKG4	TLV5610IYER	TLV990-28PFB	TPA6203A1DRB
HPA00169DGNR	TLC4545IDR	TLV5610IYZR	TLV990-28PFBG4	TPA6203A1DRBG4
HPA00177DRBR	TLC4545IDRG4	TLV5610IYZT	TLV990-40PFB	TPA6203A1DRBR
HPA00194DGNR	TLV320A1103PBSRG4	TLV5629IDW	TLV990-40PFBG4	TPA6203A1DRBRG4
HPA00198DRBR	TLV320A1110PBBSRG4	TLV5629IDWG4	TLV990BPFB	TPA6203A1GQVR
HPA00302DRBR	TLV320A1C1103GQER	TLV5629IDWR	TLV990BPFBG4	TPA6203A1ZQVR
HPA00360DRBR	TLV320A1C1103PBS	TLV5629IDWRG4	TPA6011A4PWP	TPA6203A1ZQVRG1
HPA00361DGNR	TLV320A1C1103PBSG4	TLV5629IPW	TPA6011A4PWP4	TPA6204A1DRB
HPA00379DRBR	TLV320A1C1103PBSR	TLV5629IPWG4	TPA6011A4PWR	TPA6204A1DRBG4
HPA00398DRBR	TLV320A1C1103ZQE	TLV5629IPWR	TPA6011A4PWRG4	TPA6204A1DRBR
HPA00470A1DRBR	TLV320A1C1103ZQER	TLV5629IPWRG4	TPA6019A4PWP	TPA6204A1DRBRG4
HPA00488A1ZQVR	TLV320A1C1106PW	TLV5630IDW	TPA6019A4PWP4	TPA6205A1DGN
TLC3541ID	TLV320A1C1106PWP4	TLV5630IDWG4	TPA6019A4PWR	TPA6205A1DGN4
TLC3541IDG4	TLV320A1C1106PWR	TLV5630IPW	TPA6019A4PWRG4	TPA6205A1DGNR
TLC3541IDGK	TLV320A1C1106PWRG4	TLV5630IPWG4	TPA6020A2RGWR	TPA6205A1DGNRG4
TLC3541IDGKG4	TLV320A1C1110GQER	TLV5630IPWR	TPA6020A2RGWRG4	TPA6205A1DRBR
TLC3541IDGKR	TLV320A1C1110PBS	TLV5630IPWRG4	TPA6020A2RGWT	TPA6205A1DRBRG4
TLC3541IDGKRG4	TLV320A1C1110PBSG4	TLV5631IDW	TPA6020A2RGWTG4	TPA6205A1DRBT
TLC3541IDR	TLV320A1C1110PBSR	TLV5631IDWG4	TPA6021A4N	TPA6205A1DRBTG4
TLC3541IDRG4	TLV320A1C1110ZQER	TLV5631IDWR	TPA6021A4NE4	TPA6205A1ZQVR
TLC3545ID	TLV5608IDW	TLV5631IDWRG4	TPA6201A1DGN	TPA6205A1ZQVRG1
TLC3545IDG4	TLV5608IDWG4	TLV5631IPW	TPA6201A1DGN4	TPA6211A1DGN
TLC3545IDGK	TLV5608IDWR	TLV5631IPWG4	TPA6201A1DGNR	TPA6211A1DGN4
TLC3545IDGKG4	TLV5608IDWRG4	TLV5631IPWR	TPA6201A1DGNRG4	TPA6211A1DGNR
TLC3545IDR	TLV5608IPW	TLV5631IPWRG4	TPA6201A1DRB	TPA6211A1DGNRG4
TLC3545IDRG4	TLV5608IPWG4	TLV5632IDW	TPA6201A1DRBG4	TPA6211A1DRB
TLC4541ID	TLV5608IPWR	TLV5632IDWG4	TPA6201A1DRBR	TPA6211A1DRBG4
TLC4541IDG4	TLV5608IPWRG4	TLV5632IDWR	TPA6201A1DRBRG4	TPA6211A1DRBR
TLC4541IDGK	TLV5610IDW	TLV5632IDWRG4	TPA6201A1GQVR	TPA6211A1DRBRG4
TLC4541IDGKG4	TLV5610IDWG4	TLV5632IPW	TPA6201A1ZQVR	VSP1021PFB
TLC4541IDGKR	TLV5610IDWR	TLV5632IPWG4	TPA6201A1ZQVRG1	VSP1021PFBG4
TLC4541IDGKRG4	TLV5610IDWRG4	TLV5632IPWR	TPA6202A1ZQVR	VSP1221PFB
TLC4541IDR	TLV5610IPW	TLV5632IPWRG4	TPA6202A1ZQVRG1	VSP1221PFBG4
TLC4541IDRG4	TLV5610IPWG4	TLV990-13PFB	TPA6203A1DGN	VSP2246PFB
TLC4545ID	TLV5610IPWR	TLV990-13PFBG4	TPA6203A1DGN4	VSP2246PFBG4
TLC4545IDG4	TLV5610IPWRG4	TLV990-21PFB	TPA6203A1DGNR	VSP2246PFB
TLC4545IDGK	TLV5610IYE	TLV990-21PFBG4	TPA6203A1DGNRG4	VSP2246PFBG4

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	TLV5630IDW	Die Size (mm):	1.910 X 3.118
Wafer Fab Site:	MIHO 8 (MIHO)	Wafer Fab Process:	50A12
Wafer Size:	200 mm	Metallization:	TiW/AICu.5
Die Protective Coating:	12KACN	-	-

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Life Test	125C, 1000 Hrs	112/0	112/0	112/0
Biased Temp Humidity	85C/85%RH,500 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 240 Hrs.	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	77/0
High Temp Storage Bake	150C, 1000 Hrs.	77/0	77/0	77/0
ESD - HBM	3 units/level, 500V, 1kV, 1.5kV, 2kV	12/0	12/0	12/0
ESD - CDM	3 units/level, 500V	3/0	3/0	3/0

Note: ** Moisture preconditioning required, JEDEC L-3/260C

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Device ID:	Device1	Device2	Device3	Device4
Qual Device:	TPA6203A1DRB	TPA6205A1DRB	TPA6211A1DRBR	TLV320AIC1110
Die Size:	0.98 x 0.98 (mm)	0.98 x 0.98 (mm)	47 x 47 (mils)	79 x 102 (mils)
Wafer Fab Site:	MIHO 8 (MIHO)	MIHO 8 (MIHO)	MIHO 8 (MIHO)	MIHO 8 (MIHO)
Wafer Fab Process:	50A12	50A12	50A12	33A12
Wafer Size:	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Metallization:	TiW/AICu.5	TiW/AICu.5	TiW/AICu.5	Ti/TiN/AICu.5/TiN
Die Protective Coating:	12KACN	12KACN	12KACN	8KAOX/ 9KACN

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails			
		Device1	Device2	Device3	Device4
Manufacturability (Wafer Fab)	Per mfg. site spec	Approved	Approved	Approved	Approved
Electrical Char.	Side by side comparison	30/0	30/0	30/0	30/0